

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年5月14日(2009.5.14)

【公開番号】特開2006-279049(P2006-279049A)

【公開日】平成18年10月12日(2006.10.12)

【年通号数】公開・登録公報2006-040

【出願番号】特願2006-86916(P2006-86916)

【国際特許分類】

H 01 L 21/336 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

G 02 F 1/1368 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 1 2 D

G 02 F 1/1368

H 01 L 29/78 6 2 6 C

【手続補正書】

【提出日】平成21年3月27日(2009.3.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に第1層を形成し、該第1層は複数の第1膜部材を有し、該第1膜部材は隣接する第1膜部材との間に第1間隔を有し、

前記第1層が形成された前記基板上に第2層を形成し、該第2層は複数の第2膜部材を有し、該第2膜部材は隣接する第2膜部材との間に第2間隔を有し、該第2間隔は、第1層及び第2層が形成された基板の熱膨張係数に対応する第1間隔と異なることを特徴とする薄膜パターンの形成方法。

【請求項2】

前記第2間隔の長さは、前記第1間隔の長さと前記基板の熱膨張率に対応する膨張間隔との和と同じである請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記第2間隔は、前記第1間隔より100～500ppm広い請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】

前記第2層の形成後の隣接する第1膜部材間の間隔は、実質的に第2間隔と等しい請求項1～3のいずれか1つに記載の方法。

【請求項5】

第1層及び第2層の少なくとも一方は、導電性材料からなる請求項1～4のいずれか1つに記載の方法。

【請求項6】

第1層及び第2層の少なくとも一方は、半導体材料からなる請求項1～4のいずれか1つに記載の方法。

【請求項7】

前記第2層を形成する前に前記第1層を形成した基板上に第3層を形成することをさらに含む請求項1～6のいずれか1つに記載の方法。

【請求項 8】

前記第3層は、絶縁材料からなる請求項1～7のいずれか1つに記載の方法。

【請求項 9】

基板上に薄膜パターンを形成する方法であって、

基板上に第1マスクを用いて複数の第1薄膜部材を形成し、該第1マスクは、基板上に形成される第1薄膜部材の中心部と隣接する第1薄膜部材の中心部との間に所定間隔を有し、

前記基板上に薄膜を堆積し、及び

第2マスクを用いて複数の第2薄膜部材を形成し、該第2マスクは、前記第1薄膜部材と第2薄膜部材とが形成された基板の熱膨張係数に関する間隔と、前記所定間隔との合計と等しい間隔を有して互いに離間されており、

前記隣接する第1薄膜部材の中心部は、熱膨張のために隣接する第2薄膜部材の中心部に対応することを特徴とする薄膜パターンを形成する方法。

【請求項 10】

前記基板は、プラスチック基板であり、該基板の熱膨張係数は、100～500 ppmである請求項9に記載の方法。